

# 2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン  
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

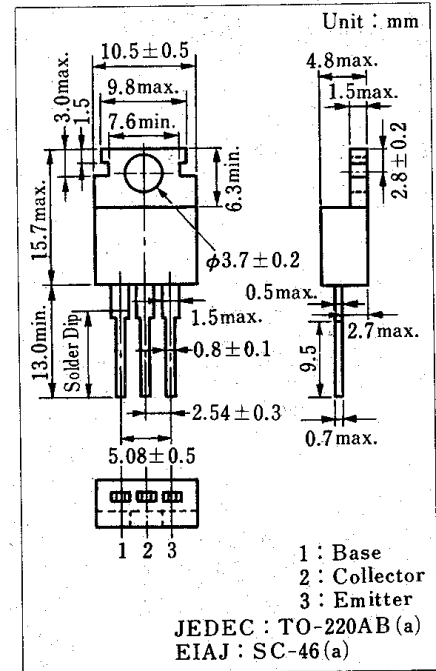
電力増幅用, スイッチング用 / Power Amplifier, Switching  
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ / Complementary Pair  
with 2SD836, 2SD836A

### ■ 特徴 / Features

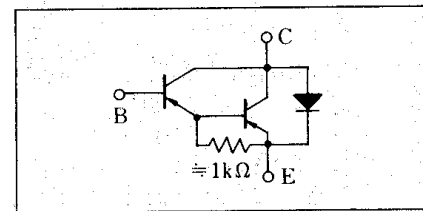
- 直流電流増幅率  $h_{FE}$  が高い。 / High  $h_{FE}$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SB750	-60	V
	2SB750A	-80	
コレクタ・エミッタ電圧	2SB750	-60	V
	2SB750A	-80	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	-5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	-4	A
コレクタ電流	$I_C$	-2	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	35	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



内部接続図 / Connection Diagram



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	2SB750	$V_{CB} = -60\text{V}, I_E = 0$			-1	mA
	2SB750A	$V_{CB} = -80\text{V}, I_E = 0$			-1	
コレクタ しゃ断電流	2SB750	$V_{CB} = -30\text{V}, I_B = 0$			-2	mA
	2SB750A	$V_{CB} = -40\text{V}, I_B = 0$			-2	
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$			-2	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SB750	$I_C = -30\text{mA}, I_B = 0$	-60			V
	2SB750A	$I_C = -30\text{mA}, I_B = 0$	-80			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}$	1000			
	$h_{FE2}^*$	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -2\text{A}$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -2\text{A}$			-2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2\text{A}, I_B = -8\text{mA}$			-2.5	V
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = -2\text{A}, I_{B1} = -8\text{mA}, I_{B2} = 8\text{mA}$		0.2		$\mu\text{s}$
ターンオフ時間	$t_{off}$			2		$\mu\text{s}$

\* $h_{FE2}$  ランク分類 /  $h_{FE2}$  Classifications

Class	R	Q	P
$h_{FE2}$	1000 ~ 2500	2000 ~ 5000	4000 ~ 10000